

---

ZP/UR/80/2013

Zał. nr 1a do siwz

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Specjalista z zakresu technologii MBE**  
w ramach projektu *Wpływ punktu Diraca na stany  
elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków  
półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnT*

### Wymagania

1. Stopień doktora w zakresie Fizyki półprzewodników albo Inżynierii Materiałowej.
2. Posiadać nie mniejsze jak 10 letnie doświadczenie badań naukowych w zakresie fizyki oraz inżynierii materiałowej dotyczącej wzrostu warstw HgTe oraz HgCdTe metodą MBE.
3. Lista publikacji (nie mniej jak 20 pozycji) w zakresie wzrostu warstw HgTe i HgCdTE metodą MBE oraz badań tych warstw.